【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年11月10日(2005.11.10)

【公開番号】特開2000-124409(P2000-124409A)
【公開日】平成12年4月28日(2000.4.28)
【出願番号】特願平10-296770
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　27/10
　Ｇ１１Ｃ　11/22
　Ｈ０１Ｌ　27/108
　Ｈ０１Ｌ　21/8242
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　27/10　　４５１
　Ｇ１１Ｃ　11/22
　Ｈ０１Ｌ　27/10　　６５１

【手続補正書】
【提出日】平成17年9月26日(2005.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】 ヒステリシス特性を有する強誘電体膜を用いた半導体記憶素子であって、
前記強誘電体膜を相対向する２つの電極で挟んで形成され、かつ前記強誘電体膜の分極方向により２値の情報を保存可能な容量素子がコントロールトランジスタのソース若しくはドレインに接続されている構造を有した半導体記憶素子の構造において、
隣り合う前記コントロールトランジスタどうしがビットラインを共有し、
また隣り合う前記容量素子どうしが各々のプレート線を共有し、
かつ前記コントロールトランジスタ上に前記容量素子を配置したこと、
を特徴とする半導体記憶素子の構造。
【請求項２】 請求項１記載の半導体記憶素子の構造において、
前記強誘電体膜は、タンタル酸ビスマスストロンチウム膜であることを特徴とする半導体記憶素子の構造。